



**Птащенко
Олександр
Олександрович**

10 січня 1940 р. н.

проф., д-р фіз.-мат. наук, зав. каф. фізики твердого тіла і
твердотільної електроніки

Контактна інформація:

Тел.: роб.: 723 58 13, дом.: 731 08 61;

Факс:

E-mail: aptash@list.ru

Державні нагороди та почесні звання:

Медаль „За освоєння целинних земель”

Основний напрямок наукової діяльності:

Твердотільна електроніка: оптоелектроніка, фізика напівпровідникових лазерів, сенсорика

Кандидатська дисертація:

“Домішкова фотопровідність та її ІЧ гасіння у напівпровідниках типу CdS”

Місце захисту:

Одеса, ОДУ імені І.І. Мечникова

Рік захисту:

1968 р.

Докторська дисертація:

Спецтема

Місце захисту:

Київ, Інститут фізики напівпровідників НАНУ

Рік захисту:

1987 р.

Дисертації, які були захищені під керівництвом ученого:

12 кандидатських дисертацій

Наукова школа: Твердотільна електроніка

Учбова діяльність (списки дисциплін, лекційні курси):

„Квантова електроніка і нелінійна фізика”,

„Фізичні основи оптоелектроніки”,

„Квантова електроніка і оптоелектроніка”,

„Проблеми сучасної фізики”.

Наукові праці з 2000 р.:

2001

Дослідження сонячного елемента : метод. вказівки до лаборатор. роботи спецпрактикуму з оптоелектроніки [Електронний ресурс] / Олександр Олександрович Птащенко. – Одеса, 2001. – 16 с. – Режим доступу : phys.onu.edu.ua.

Основи нелінійної фізики : навч. посіб. / Олександр Олександрович Птащенко. – Одеса : Астропринт, 2001. – 107 с.

2002

Керований термоядерний синтез : метод. посіб. до курсу лекцій „Проблеми сучасної фізики” [Електронний ресурс] / Олександр Олександрович Птащенко. – Одеса, 2002. – 36 с. - Режим доступу : phys.onu.edu.ua.

Короткий українсько-російсько-англійський словник термінів квантової електроніки : метод. посіб. до курсу лекцій „Нелінійна оптика і квантова електроніка” для студ. 3-го курсу [Електронний ресурс] / Олександр Олександрович Птащенко. – Одеса, 2002. – 14 с. - Режим доступу : phys.onu.edu.ua.

2004

Збірник задач з фізичних основ оптоелектроніки та квантової електроніки : метод. посіб. до курсів лекцій “Нелінійна оптика і квантова електроніка”, “Фізичні основи оптоелектроніки” та “Квантова електроніка і оптоелектроніка” для студ. 3-го і 4-го курсів [Електронний ресурс] / Олександр Олександрович Птащенко. - Одеса, 2004. – 22 с. - Режим доступу : phys.onu.edu.ua.

2006

Квантова електроніка : метод. посіб. до курсів лекцій “Нелінійна оптика і квантова електроніка” та “Квантова електроніка і оптоелектроніка” для студ. 3-го і 4-го курсів [Електронний ресурс] / Олександр Олександрович Птащенко. – Одеса, 2006. – 228 с. - Режим доступу : phys.onu.edu.ua.

2007

Лазерне охолодження атомів : метод. посіб. до курсів лекцій “Нелінійна оптика і квантова електроніка”, “Квантова електроніка і оптоелектроніка” та “Проблеми сучасної фізики” для студ. 3-го, 4-го і 5-го курсів [Електронний ресурс] / Олександр Олександрович Птащенко. – Одеса, 2007. – 33 с. - Режим доступу : phys.onu.edu.ua.

Статті:

2000

Астигматизм излучения полупроводниковых лазеров с полосковой геометрией / Александр Александрович Птащенко, Ф. А. Птащенко // Журн. приклад. спектроскопии. – 2000. – Т. 67, № 4. – С. 461-464.

Влияние окружающей атмосферы на поверхностный ток в *p-n* гетероструктурах на основе GaAs-AlGaAs / Александр Александрович Птащенко, Е. С. Артеменко, Н. В. Маслеева [и др.] // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Сер. Фіз.-мат. науки. – 2000. – Т. 5, вип. 3. – С. 185-190.

Влияние окружающей диэлектрической среды на характеристики полупроводниковых лазеров / Александр Александрович Птащенко, Ф. А. Птащенко, И. А. Волков [и др.] // Фотоэлектроника. – 2000. – Вып. 9. – С. 103-107.

Mecanical strain and degradation of laser heterostructures / A. A. Ptashchenko, F. A. Ptashchenko, N. V. Maslejeva, [et al.] // Proc. SPIE. – 2000. – Vol. 4355. – P. 79-86.

Tunnel surface recombination in *p-n* junctions / A. A. Ptashchenko, F. A. Ptashchenko // Фотоэлектроника. – 2000. – Вып. 10. – С. 69-71.

2001

Вплив газового середовища на поверхневий струм в *p-n* гетероструктурах на основі GaAs–AlGaAs / Олександр Олександрович Птащенко, О. С. Артеменко, Ф. О. Птащенко // Фізика і хімія твердого тіла. – 2001. – Т. 2, № 3. – С. 481-485.

Вплив парів аміаку на поверхневий струм *p-n* структур на основі напівпровідників $A^{III}B^V$ / Олександр Олександрович Птащенко, О. С. Артеменко, Н. В. Маслеева [та ін.] // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Сер. Фіз.-мат. науки. – 2001. – Т. 6, вип. 3. – С. 147-153.

2002

Проводимость в твердом состоянии и каталитическая активность гексацианоферрат (II)–тиосемикарбазидных комплексов 3d-металлов / Александр Александрович Птащенко, Т. В. Кокшарова, Н. В. Маслеева [и др.] // Теорет. и эксперим. химия. – 2002. – Т. 38, № 4. – С. 257-261.

Рефрактометричні характеристики напівпровідникових лазерів / Олександр Олександрович Птащенко, Ф. О. Птащенко // Фотоелектроніка. – 2002. – Вип. 11. – С. 76-80.

2003

Вплив парів аміаку на поверхневий струм в р-п переходах на основі напівпровідників A^3B^5 / Олександр Олександрович Птащенко, О. С. Артеменко, Ф. О. Птащенко // Журн. фіз. дослідж. – 2003. – Т. 7, № 4. – С. 419-425.

Кінетика поверхневого струму, пов'язаного з адсорбцією іонів, у р-п переходах / Олександр Олександрович Птащенко, О. С. Артеменко, Ф. О. Птащенко // Фотоелектроніка. – 2003. – Вип. 12. – С. 47-50.

2005

Лазерні гетероструктури як оптоелектронні сенсори / Олександр Олександрович Птащенко, Ф. О. Птащенко // Вісн. Черкас. держ. технол. ун-ту. – 2005. – № 3. – С. 241-243.

Effect of ammonia vapors on the surface morphology and surface current in p-n junctions on GaP / A. A. Ptashchenko, O. S. Artemenko, M. L. Dmytruk [et al.] // Photoelectronics. – 2005. – № 14. – P. 97-100.

2006

Р-п переходи як селективні газові сенсори / Олександр Олександрович Птащенко, О. С. Артеменко, Н. В. Маслєєва, [та ін.] // Вісн. Черкас. держ. технол. ун-ту. – 2006. – Спецвип. – С. 238-240.

Характеристики напівпровідникових лазерів як рефрактометричних елементів / Олександр Олександрович Птащенко, Ф. О. Птащенко // Вісн. Черкас. держ. технол. ун-ту. – 2006. – Спецвип. – С. 241-243.

Degradation of semiconductor devices : non-destructive diagnostics / O. O. Ptashchenko, F. O. Ptashchenko // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Сер. Фіз.-мат. науки. – 2006. – Т. 11, вип. 7. – С. 3-18.

Effect of ammonia vapors on the surface current in silicon p-n junctions / Ptashchenko O.O., Ptashchenko F.O., Yemets O.V. // Photoelectronics. – 2006. – № 16. – P. 89-93.

2007

Effect of sulfur atoms on the surface current in GaAs p-n junctions / Ptashchenko O.O., Ptashchenko F.O., Masleyeva N.V. [and other] // Photoelectronics. – 2007. – № 17. – P. 36-39.

Доповіді на конференціях:

2008

Вплив атомів сірки на характеристики р-п переходів на основі GaAs як газових сенсорів / Олександр Олександрович Птащенко, Ф. О. Птащенко // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології (СЕМСТ-3) : тез. доп. міжнар. наук.-техн. конференції (2-6 черв. 2008 р., м. Одеса). - Одеса : Астропринт, 2008. - С. 187.

Характеристики Р-п переходів на основі InGaN як газових сенсорів / Олександр Олександрович Птащенко, Ф. О. Птащенко // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології (СЕМСТ-3) : тез. доп. міжнар. наук.–техн. конференції (2-6 черв. 2008 р., м. Одеса). - Одеса : Астропринт, 2008. - С. 81.

Поетичні збірки:

2003

Любов і біль : поезії / Олександр Олександрович Птащенко. – Одеса : Маяк, 2003. – 80 с.

2006

Нищені – не знищені / Олександр Олександрович Птащенко ; ред. О. С. Різників. – Одеса : Астропринт, 2006. – 48 с.

Відкриття, патенти, винаходи:

Участь у національних, міжнародних організаціях, асоціаціях:

Член Українського фізичного товариства; член Товариства „Просвіта”.

Участь у національних, міжнародних заходах:

Учасник багатьох міжнародних та національних наукових конференцій.